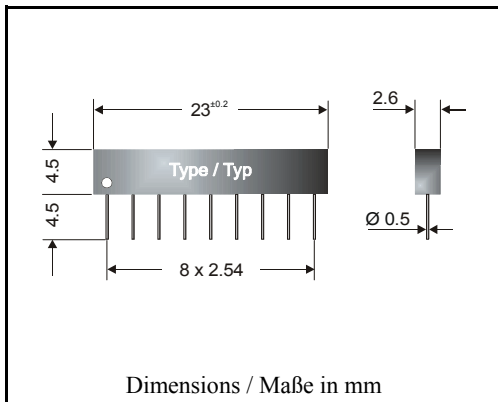
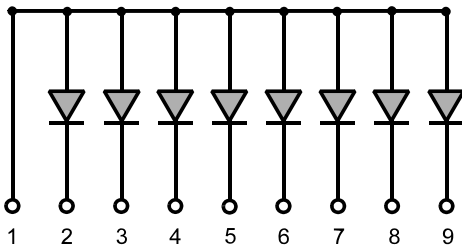


**Fast Switching Rectifier Arrays**

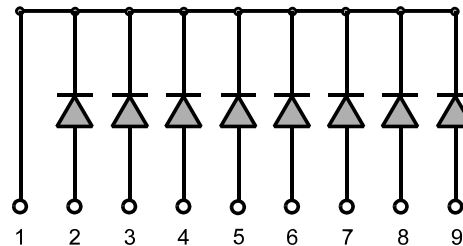
**Schnelle Gleichrichter Sätze**



Nominal power dissipation Nenn-Verlustleistung	1.2 W
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	100...400 V
9 Pin-Plastic case 9 Pin-Kunststoffgehäuse	23 x 2.6 x 4.5 [mm]
Weight approx. – Gewicht ca.	0.6 g
Standard packaging: bulk Standard Lieferform: lose im Karton	see page 22 s. Seite 22



"DA 811 A...8110 A": com. anodes / gem. Anoden



"DA 811 K...8110 K" : com. cathodes / gem. Kathoden

**Maximum ratings**

**Grenzwerte**

Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung $V_{RRM}$ [V]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung $V_{RSM}$ [V]
DAF 811 A/K	100	120
DAF 814 A/K	400	480

Max. average forward rectified current, R-load, for one diode operation only per diode for simultaneous operation	$T_A = 25^\circ\text{C}$	$I_{FAV}$	600 mA <sup>1)</sup>
		$I_{FAV}$	150 mA <sup>1)</sup>
Dauergrenzstrom in Einwegschtung mit R-Last, für eine einzelne Diode pro Diode bei gleichzeitigem Betrieb	$T_U = 25^\circ\text{C}$	$I_{FAV}$	600 mA <sup>1)</sup>
		$I_{FAV}$	150 mA <sup>1)</sup>
Peak forward surge current, 50 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50 Hz Sinus-Halbwelle	$T_A = 25^\circ\text{C}$	$I_{FSM}$	30 A

<sup>1)</sup> Leads kept at ambient temperature at a distance of 3 mm from case  
Anschlußdrähte in 3 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten

Max. power dissipation – Verlustleistung	$T_A = 25^\circ\text{C}$	$P_{\text{tot}}$	$1.2\text{ W}^1)$
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur		$T_j$	$-50\dots+150^\circ\text{C}$
Storage temperature – Lagerungstemperatur		$T_S$	$-50\dots+150^\circ\text{C}$

Characteristics		Kennwerte		
Forward voltage Durchlaßspannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$I_F = 1\text{ A}$	$V_F$	$< 1.3\text{ V}$
Leakage current Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$V_R = V_{\text{RRM}}$	$I_R$	$< 10\ \mu\text{A}$
	$T_j = 100^\circ\text{C}$	$V_R = V_{\text{RRM}}$	$I_R$	$< 90\ \mu\text{A}$
Reverse recovery time Sperrverzug	$I_F = 10\text{ mA}$ through/über $I_R = 10\text{ mA}$ to/auf $I_R = 1\text{ mA}$		$t_{\text{rr}}$	$< 350\text{ ns}$
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft			$R_{\text{thA}}$	$< 85\text{ K/W}^1)$

<sup>1)</sup> Leads kept at ambient temperature at a distance of 3 mm from case  
Anschlußdrähte in 3 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten